晶体结构

正格

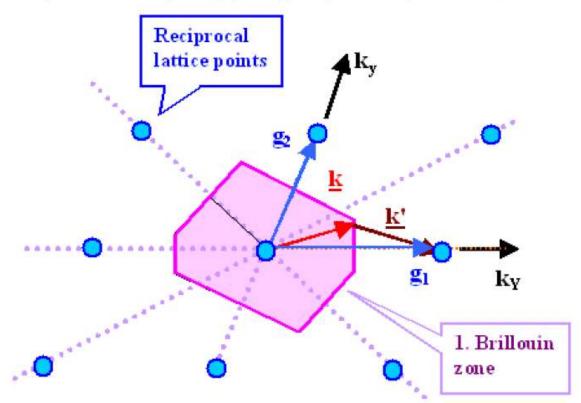
1.
$$\vec{R}_n = \vec{n_1}\vec{a_1} + \vec{n_2}\vec{a_2} + \vec{n_3}\vec{a_3}$$

- 2.与晶体中原子位置 相对应;
- 3.是真实空间中点的 周期性排列;
- 4.线度量纲为[长度]

倒格

- 1. $\vec{K}_n = h_1' \vec{b}_1 + h_2' \vec{b}_2 + h_3' \vec{b}_3$
- 2.与晶体中一族晶面相对应;
- 3.是与真实空间相联系的傅里叶空间中点的周期性排列;
- 4.线度量纲为[长度]-1

任选一倒格点为原点,从原点向它的第一、第二、第三……近邻倒格点画出倒格矢,并作这些倒格矢的中垂面,这些中垂面绕原点所围成的多面体称第一布里渊区,其"体积"为倒格子原胞体积 $\Omega^*=b_1\cdot(b_2\times b_3)$



◆第一布里渊区又可表述为从原点出发,不与任何中垂面相交,所能达到的倒空间区域。第n个布里渊区则是从原点出发跨过(n-1)个倒格矢中垂面所达到的区域;

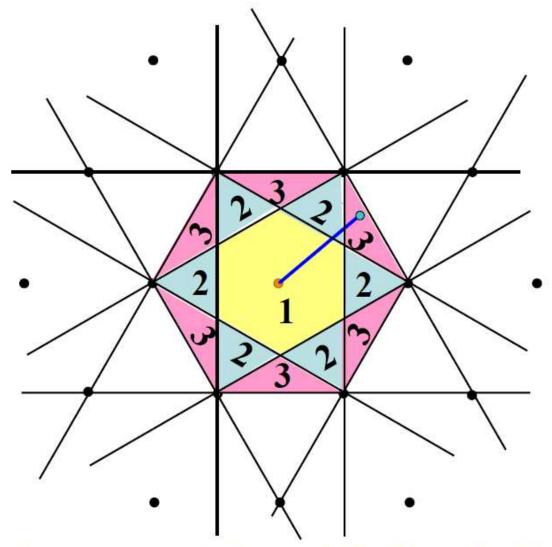
◆各级布里渊区的体积相等。

布里渊区的边界面是倒格矢的垂直平分面

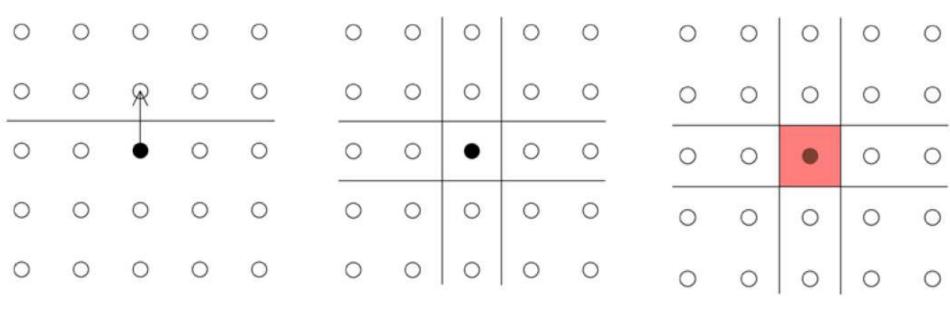
布里渊区的几何作图法:

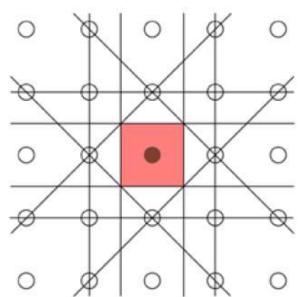
- 根据晶体结构,作出该晶体的倒易空间点阵, 任取一个倒格点为原点;
- 🌣 由近到远作各倒格矢的垂直平分面;
- ❖ 在原点周围围成一个包含原点在内的最小封闭体积,即为简约区或第一布里渊区。

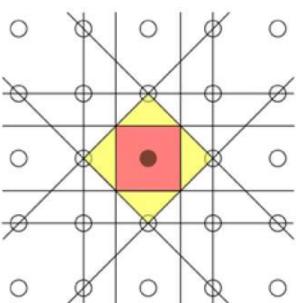
简约区就是倒易空间中的Wigner-Seitz原胞

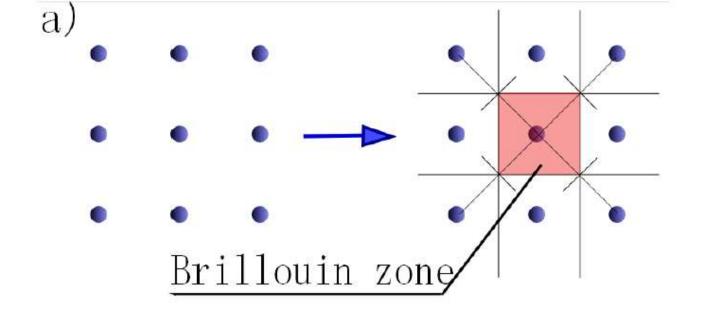


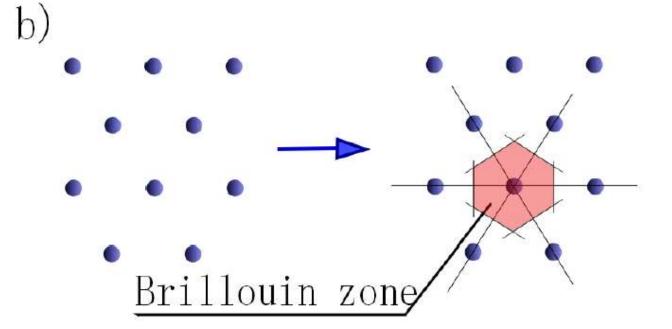
每个布里渊区的体积均相等,都等于第一 布里渊区的体积,即倒格子原胞的体积Ω_b

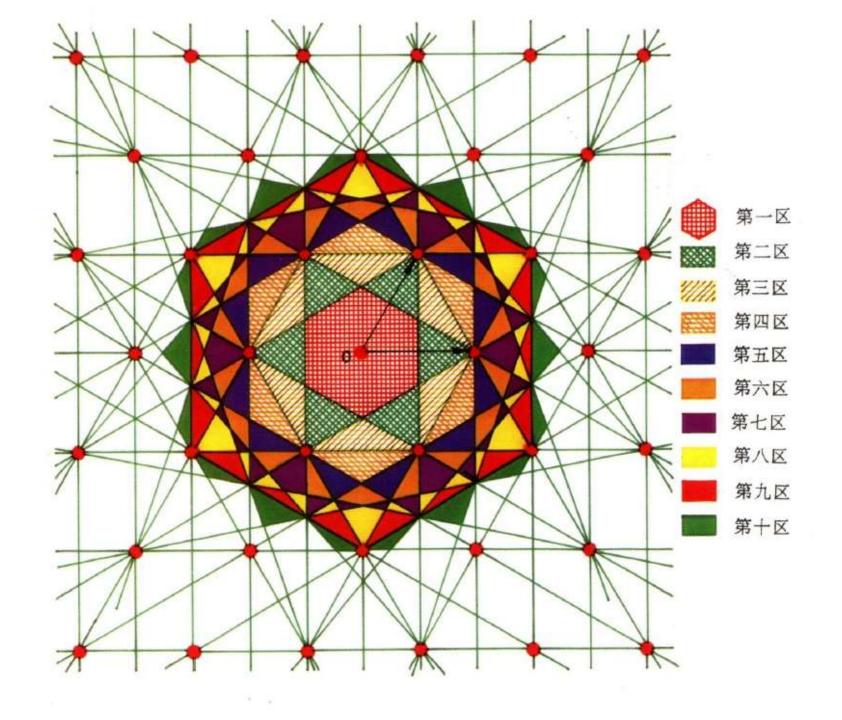




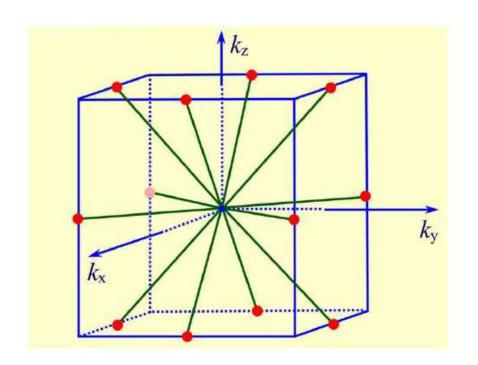


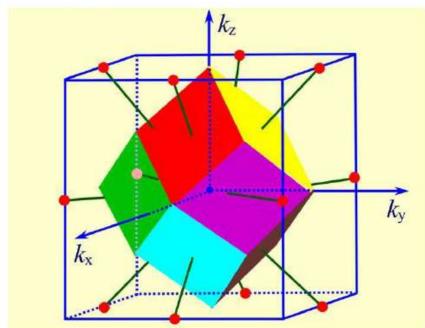




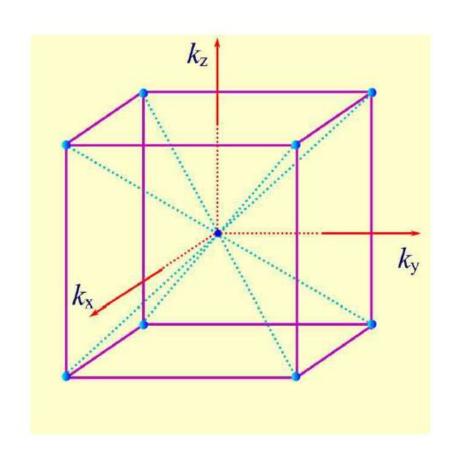


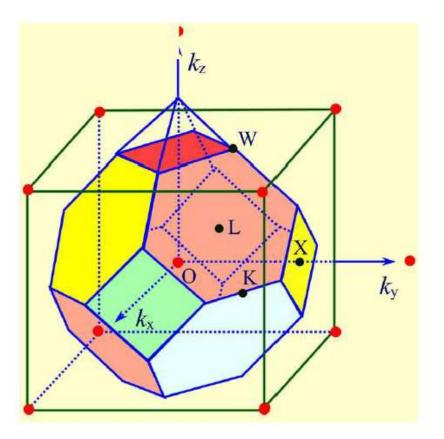
正格子	格常数	倒格子	格常数	简约区 (第一布里渊区)
sc	a	sc	$\frac{2\pi}{a}$	由6个{100}面 围成的立方体
bcc	a	fcc	$\frac{4\pi}{a}$	由12个{110}面 围成的正12面体
fcc	a	bec	$\frac{4\pi}{a}$	由8个{111}面和6个{100} 面围成的14面体





体心立方晶格的倒格子与简约区





面心立方晶格的倒格子与简约区

晶体表面相 (扩展知识,不做要求)

对于晶体表面结构的研究表明,晶体表面的结构不完全是晶体内部相应结构的面的延续

晶体表面是晶体三维周期性结构和真空之间的过渡层,可以将它看作是特殊的相——表面相

晶体内部与表面平行的平面基矢 $ar{a}_1$ and $ar{a}_2$

晶体表面二维晶格基矢 \bar{a}_1^s and \bar{a}_2^s

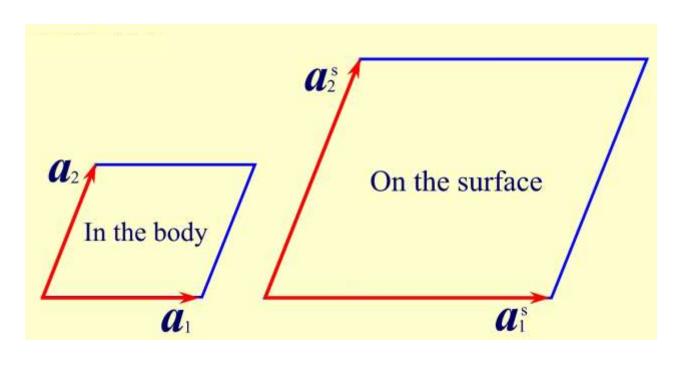
这两族基矢有可能是不同的 —— 表面的再构

典型表面再构之一
$$R(h_1, h_2, h_3)_{p \times q}$$
 $\bar{a}_1 / /\bar{a}_1^s$ and $\bar{a}_2 / /\bar{a}_2^s$; $\bar{a}_1^s = p\bar{a}_1$ and $\bar{a}_2^s = q\bar{a}_2$

 $R ext{ —— 晶体材料 } h_1h_2h_3 ext{ —— 晶体表面平面的密勒指数}$

$$Si(111)_{7\times7}$$

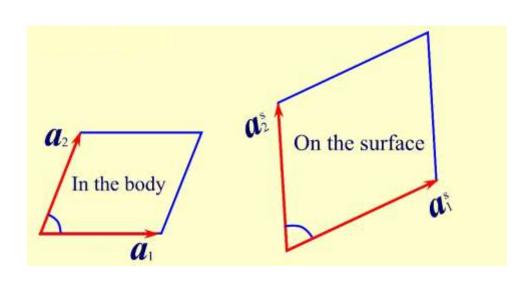
—— 硅(111)表面原子排列的周期为体内相应平面的7倍



典型表面再构之二 —— $R(h_1, h_2, h_3)_{p \times q - Q}$

No
$$\vec{a}_1 / / \vec{a}_1^s$$
 and $\vec{a}_2 / / \vec{a}_2^s$
 $\angle \vec{a}_1, \vec{a}_2 = \angle \vec{a}_1^s, \vec{a}_2^s$

例如 $Ni(100)_{\sqrt{2}\times\sqrt{2}-45^0(S)}$



—— 其中S为表面吸附原子

—— 不同的方法可以获得不同的再构表面,表面的再构现象与表面原子的驰豫、原子的吸附有关,通常可由低能电子衍射(LEED)获得表面再构的几何规律

第二章

固体的结合

第二章 固体的结合

- •2.1: 离子性结合
- •2.2: 共价结合
- 2.3: 金属性结合
- 2.4: 范德瓦尔斯结合
- •2.5: 元素和化合物结合的规律性

学习目的:

从晶体的<u>几何对称性</u>观点讨论了<u>固体的分类</u>! 很难直接看到<u>晶体结构</u>对其<u>性能</u>影响的<u>物理本质</u>

原子或离子间的相互作用或结合的性质与固体材料的结构和物理、化学性质有密切关系,是研究固体材料性质的重要基础!

物理本质:)全部归因于静电吸引作用!

规律性: 晶体的结合决定于其组成粒子间的相互作用 → <u>化学键</u>→由<u>结合能及结合力</u>来反映!

晶体结合能的普遍规律

晶体的结合能就是将自由的原子(离子或分子)结合 成晶体时所释放的能量。

$$E_{\scriptscriptstyle b} = E_{\scriptscriptstyle N} - E_{\scriptscriptstyle 0}$$

 E_0 是晶体的总能量, E_N 是组成该晶体的N个原子在自由状态时的总能量, E_N 即为晶体的结合能。

原子间的相互作用力

相互作用势能

$$u(r) = -\frac{A}{r^m} + \frac{B}{r^n}$$

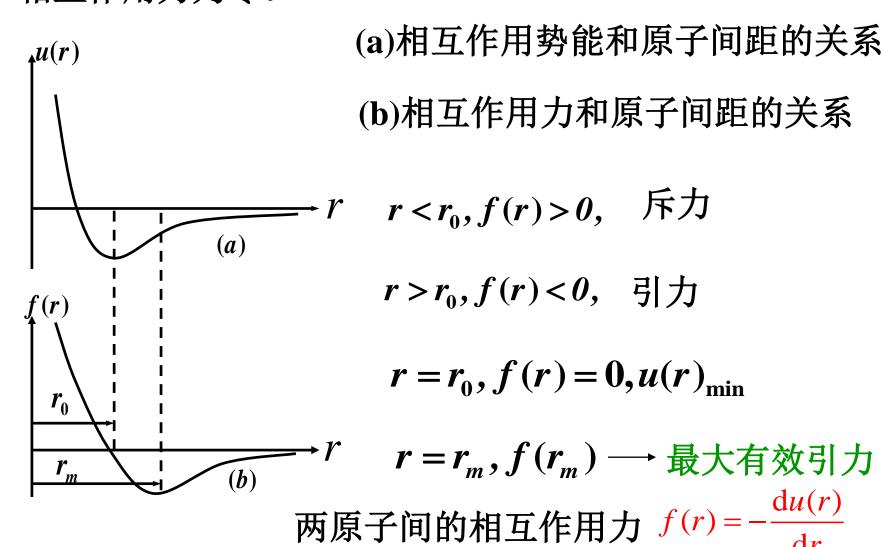
$$f(r) = -\frac{\mathrm{d}u(r)}{\mathrm{d}r}$$

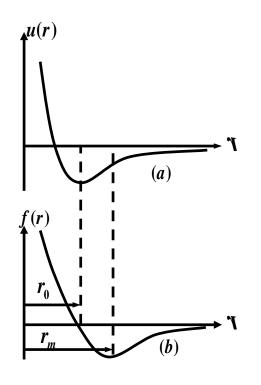
两原子间的距离; $A \setminus B \setminus m \setminus n > 0$,

$$A \setminus B \setminus m \setminus n > 0$$

$$-rac{A}{r^m}$$
 — 吸引能 $+rac{B}{r^n}$ —

假设相距无穷远的两个自由原子间的相互作用能为零,相互作用力为零。





$$-\left(\frac{\mathbf{d}u}{\mathbf{d}r}\right)/_{r=r_0}=0\implies r_0$$

 $(r_0$ 平衡时原子间最近邻的距离。)

$$\left(\frac{\mathbf{d}^2 u}{\mathbf{d}r^2}\right)_{r_0} > 0$$

 $(r=r_0$ 处相互作用能有最小值。)

$$u(r) = -\frac{A}{r^m} + \frac{B}{r^n} \qquad (\frac{d^2u}{dr^2}) = \frac{m(m+1)(n-m)A}{(m+1)r_0^{m+2}} > 0$$

可知n >m, 排斥作用是短程的。

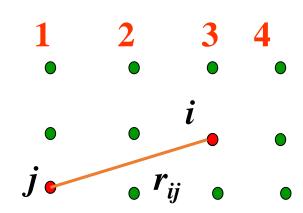
晶体总的相互作用能

设晶体中第i个原子与第j个原子之间的相互作用势能为 $u(r_{ij})$,

第*i*个原子与晶体中所有其它原子的相互作用势能为:

$$u_i = \sum_{j=1}^N u(r_{ij})$$

则由N个原子组成的晶体的总的相互作用势能为:



$$u(r) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} u_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} u(r_{ij})$$

因为晶体中原子数很多,因此晶体表面原子与晶体内部原子的差别可以忽略,上式近似为:

$$U(r) = \frac{N}{2}u_i = \frac{N}{2} \sum_{j=1}^{N} u(r_{ij})$$

$$U(r)$$
 $\left\{egin{array}{c} 原子数目 \\ 原子间距 \end{array}
ight\}$ 晶体体积的函数 $U(v)$

若取 $E_N=0$,则晶体的结合能:

$$E_b = E_N - E_0 = -E_0 = -U(r_0)$$

§ 2.1 离子性结合

I 族碱金属元素 —— Li、Na、K、Rb、Cs

VII 族的卤素元素 —— F、Cl、Br、I

结合为离子晶体 —— NaCl, CsCl等

半导体材料 —— CdS、ZnS

1. 离子晶体结合的特点

CsCl晶体 —— Cs原子失去电子,Cl获得电子,形成离子键

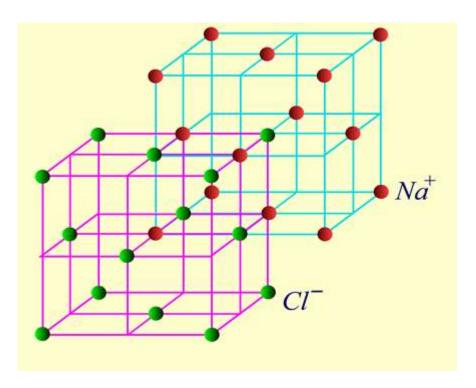
——离子为结合单元,电子分布高度局域在离子实的附近, 形成稳定的球对称性的电子壳层结构

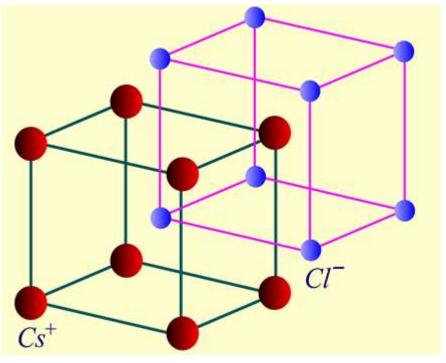
$$Na^{+} \Rightarrow Ne, \quad K^{+} \Rightarrow Ar, \quad Rb^{+} \Rightarrow Kr, \quad Cs^{+} \Rightarrow Xe$$
 $F^{-} \Rightarrow Ne, \quad Cl^{-} \Rightarrow Ar, \quad Br^{-} \Rightarrow Kr, \quad I^{-} \Rightarrow Xe$

- 図 离子晶体的模型:正、负离子 —— 刚球
- 図 离子晶体结合力
- —— 库仑吸引力作用
- —— 排斥力: 靠近到一定程度,由于泡利不相容原理,两个离子的闭合壳层电子云的交迭产生强大的排斥力
- —— 排斥力和吸引力相互平衡时,形成稳定的离子 晶体
 - ☑ 一种离子的最近邻离子为异性离子
 - 図 离子晶体的配位数最多只能是8(例如CsCl晶体)
 - 离子晶体结合的稳定性 —— 导电性能差、熔点高、 硬度高和膨胀系数小

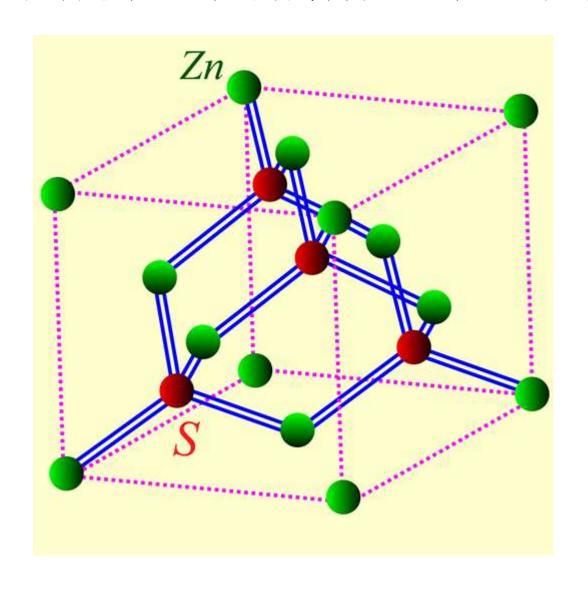
氯化钠型 —— NaCl、KCl、AgBr、PbS、MgO (配位数6)

氯化铯型——CsCl、TlBr、TlI(配位数8)





离子结合成分较大的半导体材料ZnS等(配位数4)



- 2. 离子晶体结合的性质
 - 1) 系统内能的计算

晶体内能 —— 所有离子相互吸引库仑能和重叠排斥能之和

以NaCl晶体为例,r —— 相邻正负离子的距离

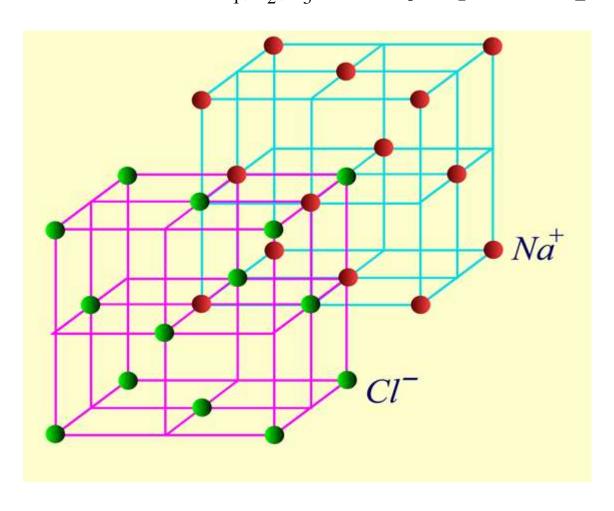
☑ 一个正离子的平均库仑能

$$\frac{1}{2} \sum_{n_1, n_2, n_3} \frac{q^2 (-1)^{n_1 + n_2 + n_3}}{4\pi \varepsilon_0 (n_1^2 r^2 + n_2^2 r^2 + n_3^2 r^2)^{1/2}} \qquad n_1, n_2, n_3$$
——正整数

—— 求和遍及所有正负离子

—— 因子1/2:库仑相互作用能为两个离子所共有

正离子的平均库仑能 $\frac{1}{2}\sum_{n_1,n_2,n_3}$ ' $\frac{q^2(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{4\pi\varepsilon_0(n_1^2r^2+n_2^2r^2+n_3^2r^2)^{1/2}}$



☑一个负离子的平均库仑能

$$\frac{1}{2} \sum_{n_1, n_2, n_3} \frac{(-q)^2 (-1)^{n_1 + n_2 + n_3}}{4\pi \varepsilon_0 (n_1^2 r^2 + n_2^2 r^2 + n_3^2 r^2)^{1/2}} n_1, n_2, n_3$$

—— 求和遍及所有正负离子

—— 因子1/2: 库仑相互作用能为两个离子所共有

☑ 一个原胞有两个离子,其原胞的能量

$$\sum_{n_1, n_2, n_3} \frac{q^2 (-1)^{n_1 + n_2 + n_3}}{4\pi \varepsilon_0 (n_1^2 r^2 + n_2^2 r^2 + n_3^2 r^2)^{1/2}}$$

$$\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \sum_{n_1, n_2, n_3} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)^{1/2}} = -\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$-\alpha = \sum_{n_1, n_2, n_3} \frac{(-1)^{n_1 + n_2 + n_3}}{(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)^{1/2}} - \alpha 马德隆常数 取决于晶体的结构$$

几种常见的晶体晶格的马德隆常数

离子晶体	NaCl	CsCl	ZnS
马德隆常数	1.748	1.763	1.638

相邻两个离子因电子云有显著重叠时的排斥能

$$be^{-r/r_0}$$
 or $\frac{b}{r^n}$

NaCl — 计近邻离子排斥作用,每个原胞平均排斥能

☑ 晶体中有N个原胞,系统的内能

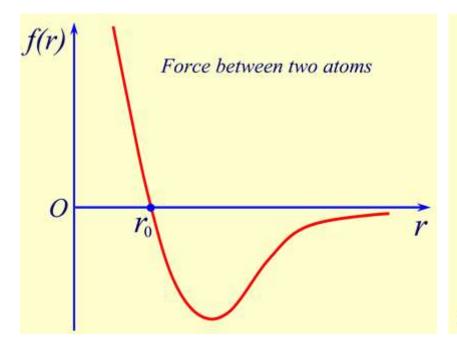
$$U = N\left[-\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + 6\frac{b}{r^n}\right] = N\left[-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n}\right]$$

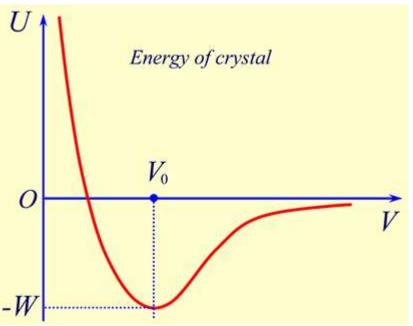
$$A = -\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0}, \ B = 6b$$

2) 平衡时晶体的体积和晶格常数 原子形成晶体以后,系统具有更低的能量

—— 如果分散周期性排列的原子构成的系统,其内能为零,形成晶体时内能降低,放出能量W,称W为结合能

-W —— 结合成晶体后系统的内能



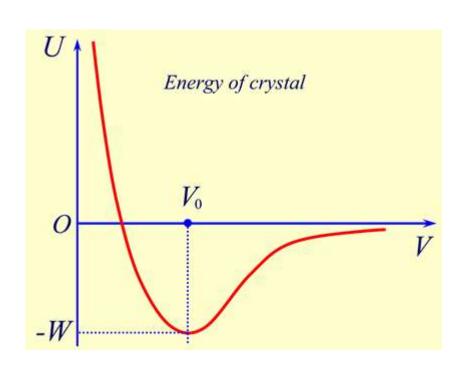


不考虑热效应, 外界作功等于系统内能增量

$$-pdV = dU \quad p = -\frac{dU}{dV}$$

一般条件下,晶体只受大气压的作用,对晶体体积的影响很小

——如果已知晶体的内能,根据极值条件来确定晶体平衡时的体积和晶格常数



NaCl晶体的内能
$$U = N[-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n}]$$

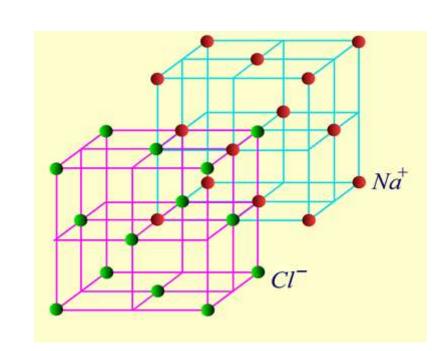
晶格常数
$$\frac{dU}{dr}\Big|_{r=r_0} = 0 - \frac{A}{r_0^2} + \frac{nB}{r_0^{n+1}} = 0$$

NaCl的晶格常数
$$r_0 = (\frac{nB}{A})^{\frac{1}{n-1}}$$

NaCl原胞体积
$$\frac{1}{4}a^3 = \frac{1}{4}(2r_0)^3$$

$$=2r_0^3$$

NaCl晶体体积
$$V_0 = 2Nr_0^3$$



3) 晶体的体变模量和结合能

体变模量
$$K = \frac{dp}{-dV/V}$$
 $p = -\frac{dU}{dV}$ $K = (V\frac{d^2U}{dV^2})$ 平衡状态 $K = (V\frac{d^2U}{dV^2})_{V_0}$ $U = N[-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n}]$ $V_0 = 2Nr_0^3$
$$K = \frac{1}{18r_0}[-\frac{2A}{r_0^3} + \frac{n(n+1)B}{r_0^{n+2}}]$$
 $\frac{dU}{dr}\Big|_{r=r_0} = 0$ $-\frac{A}{r_0^2} + \frac{nB}{r_0^{n+1}} = 0$ $A = -\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0}$

体变模量
$$K = \frac{(n-1)\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 \times 18r_0^4}$$

体变模量
$$K = \frac{(n-1)\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 \times 18r_0^4}$$

—— 实验测得的晶格常数 r_0 和体变模量K,由上式可以确定排斥力中的参数 n

晶体的结合能
$$W = -U(r_0)$$
 $U = N[-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n}]$

利用
$$\frac{dU}{dr}\Big|_{r=r_0} = 0$$
 $-\frac{A}{r_0^2} + \frac{nB}{r_0^{n+1}} = 0$ $A = -\frac{\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0}$

$$W = \frac{N\alpha q^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0} (1 - \frac{1}{n})$$

§ 2.2 共价结合

☑ 共价结合是靠两个原子各贡献一个电子 —— 形成共价键

☑ 共价键的现代理论 —— 以氢分子的量子理论为基础

——两个氢原子A和B,在自由状态下时,各有一个电子

—— 归一化波函数 ϕ_A and ϕ_B

单个原子中的电子的波函数 ϕ_A and ϕ_B

分别满足薛定谔方程

$$(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_A)\phi_A = \varepsilon_A\phi_A$$

$$(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_B)\phi_B = \varepsilon_B\phi_B$$

 V_A , V_B —— 原子核的库仑势

- —— 当原子相互靠近,波函数交叠,形成共价键
- —— 两个电子为两个氢原子所共有

描写其状态的哈密顿量

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_2^2 + V_{A1} + V_{A2} + V_{B1} + V_{B2} + V_{12}$$

—— 下标A和B代表两个原子,1和2代表两个电子

薛定谔方程 $H\psi = E\psi$

- —— 忽略两个电子之间的相互作用 V_{12} ,简化为单电子问题
- —— 假定两个电子总的波函数 $\psi(\bar{r}_1, \bar{r}_2) = \psi_1(\bar{r})\psi_2(\bar{r})$

分子轨道波函数

$$\psi_1(\vec{r}), \psi_2(\vec{r})$$

满足薛定谔方程

$$(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 + V_{A1} + V_{B1})\psi_1 = \varepsilon_1\psi_1$$

$$(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 + V_{A2} + V_{B2})\psi_2 = \varepsilon_2\psi_2$$

——单电子波动方程

两个等价的原子A和B $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_0$

选取分子轨道波函数为原子轨道波函数的线性组合

$$\psi_i(\vec{r}) = C_i[\phi_A(\vec{r}) + \lambda_i \phi_B(\vec{r})]$$

Linear Combination of Atomic Orbitals —— LCAO

分子轨道波函数 $\psi_i(\vec{r}) = C_i[\phi_A(\vec{r}) + \lambda_i\phi_B(\vec{r})]$

—— 变分计算待定因子 $\lambda = \pm 1$

—— 归一化常数

分子轨道波函数

$$\psi_{+} = C_{+}(\varphi_{A} + \varphi_{B})$$
 Bonding state

 $\psi_{-} = C_{-}(\varphi_{A} - \varphi_{B})$ Antibonding state

分子轨道波函数
$$\psi_{+} = C_{+}(\phi_{A} + \phi_{B}), \ \psi_{-} = C_{-}(\phi_{A} - \phi_{B})$$

两种分子轨道
$$\mathcal{E}_{+} = \frac{\int \psi_{+}^{*} H \psi_{+} d\bar{r}}{\int \psi_{+}^{*} \psi_{+} d\bar{r}} = 2C_{+}^{2} (H_{aa} + H_{ab})$$

$$\varepsilon_{-} = \frac{\int \psi_{-}^{*} H \psi_{-} d\vec{r}}{\int \psi_{-}^{*} \psi_{-} d\vec{r}} = 2C_{-}^{2} (H_{aa} - H_{ab})$$

$$\mathcal{E}_{\scriptscriptstyle \perp} < \mathcal{E}_{\scriptscriptstyle \perp}$$

$$H_{aa} = \int \phi_A^* H \phi_A d\vec{r} = \int \phi_B^* H \phi_B d\vec{r} \approx \varepsilon_0$$

$$H_{ab} = \int \phi_A^* H \phi_B d\vec{r} = \int \phi_B^* H \phi_A d\vec{r} < 0$$

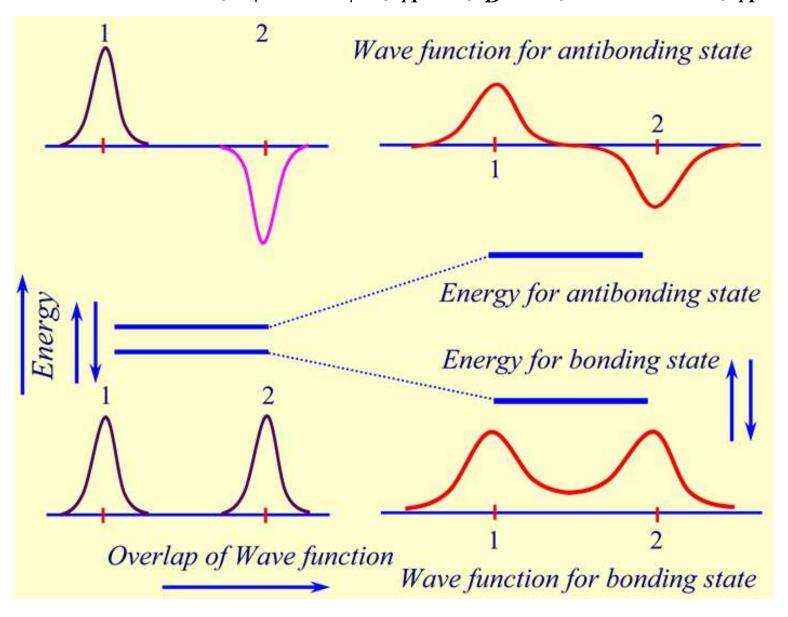
$$\varepsilon_{+} = \frac{\int \psi_{+}^{*} H \psi_{+} d\vec{r}}{\int \psi_{+}^{*} \psi_{+} d\vec{r}} = 2C_{+}^{2} (H_{aa} + H_{ab})$$

$$\varepsilon_{-} = \frac{\int \psi_{-}^{*} H \psi_{-} d\vec{r}}{\int \psi_{-}^{*} \psi_{-} d\vec{r}} = 2C_{-}^{2} (H_{aa} - H_{ab})$$

—— 负电子云与原子核之间的库仑作用,成键态能量相对于原子能级降低了,与此同时反键态的能量升高

—— 成键态上可以填充两个自旋相反的电子,使体系的能量下降,意味着有相互吸引的作用

分子轨道波函数 $\psi_{+} = C_{+}(\phi_{A} + \phi_{B}), \ \psi_{-} = C_{-}(\phi_{A} - \phi_{B})$



共价键结合的两个基本特征 —— 饱和性和方向性

应 饱和性 —— 共价键形式结合的原子能形成的键的数目 有一个最大值,每个键含有2个电子,分别来自两个原子

—— 共价键是由未配对的电子形成

—— 价电子壳层如果不到半满,所有电子都可以是不配对的,因此成键的数目就是价电子数目

—— 价电子壳层超过半满时,根据泡利原理,部分电子必须自旋相反配对,形成的共价键数目小于价电子数目

IV族 — VII族的元素共价键数目符合8一N原则

应 方向性 —— 原子只在特定的方向上形成共价键,各个共价键之间

根据共价键的量子理论,共价键的强弱取决于形成共价键的两个电子轨道相互交叠的程度 —— 一个原子在价电子波函数最大的方向上形成

共价键

- —— 对于金刚石中C原子形成的共价键
- ,要用"轨道杂化"理论进行解释
 - 原子 —— 6个电子, 1s², 2s²和2p²。
- —— 只有2个电子是未配对的
- —— 而在金刚石中每个C原子和4个近邻C原子形成 共价键

金刚石共价键的基态由2s和2p波函数的组合构成

$$\psi_{h_1} = \frac{1}{2} (\phi_{2s} + \phi_{2p_x} + \phi_{2p_y} + \phi_{2p_z})$$

$$\psi_{h_2} = \frac{1}{2} (\phi_{2s} + \phi_{2p_x} - \phi_{2p_y} - \phi_{2p_z})$$

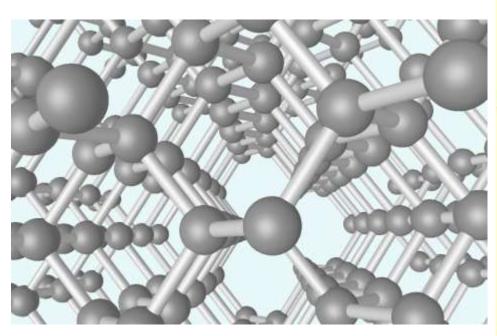
$$\psi_{h_3} = \frac{1}{2} (\phi_{2s} - \phi_{2p_x} + \phi_{2p_y} - \phi_{2p_z})$$

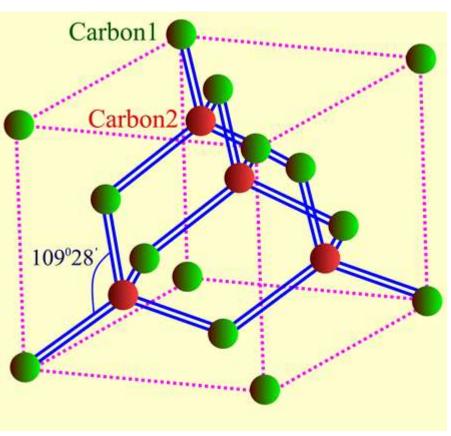
$$\psi_{h_4} = \frac{1}{2} (\phi_{2s} - \phi_{2p_x} - \phi_{2p_y} + \phi_{2p_z})$$

杂化轨道的特点 —— 电子云分别集中在四面体的4个顶角方向上,2个2s和2个2p电子都是未配对的,在四面体顶角方向上形成4个共价键

—— 两个键之间的夹角: 109°28°

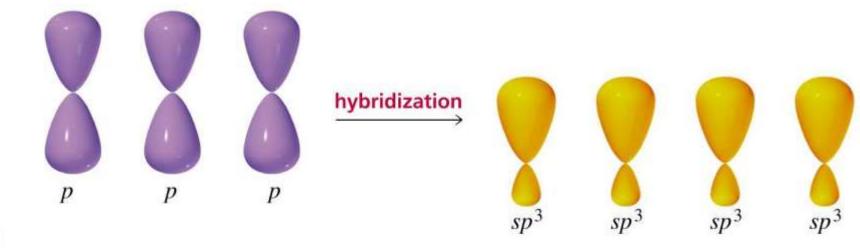
Diamond





sp³杂化轨道

- 25% s 轨道 + 75% p 轨道 = sp^3 杂化轨道.
- $- \gamma_s$ 轨道和三个p 组合形成四个 sp^3 杂化轨道
- $- r^3$ 杂化轨道的能量低于p 轨道,高于s 轨道





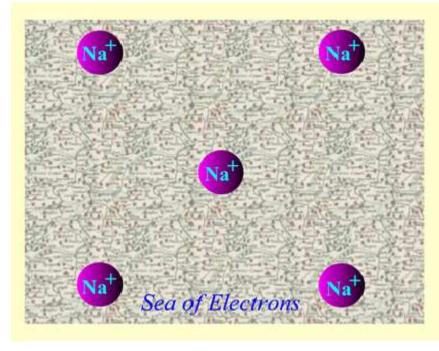
§ 2.3 金属性结合

I族、II族元素及过渡元素 —— 典型的金属晶体,最外层电子一般为1~2个

组成晶体时每个原子最外层电 子为所有原子所共有

价电子 —— 电子云

原子实 —— 沉浸在电子云



电子云和原子实的作用 —— 库仑作用 体积越小电子云密度越高,库仑相互作用 的能愈低,表现为原子聚合起来的作用 ☑ 晶体的平衡 —— 依靠库仑作用力和一定的排斥力排斥来自两个方面

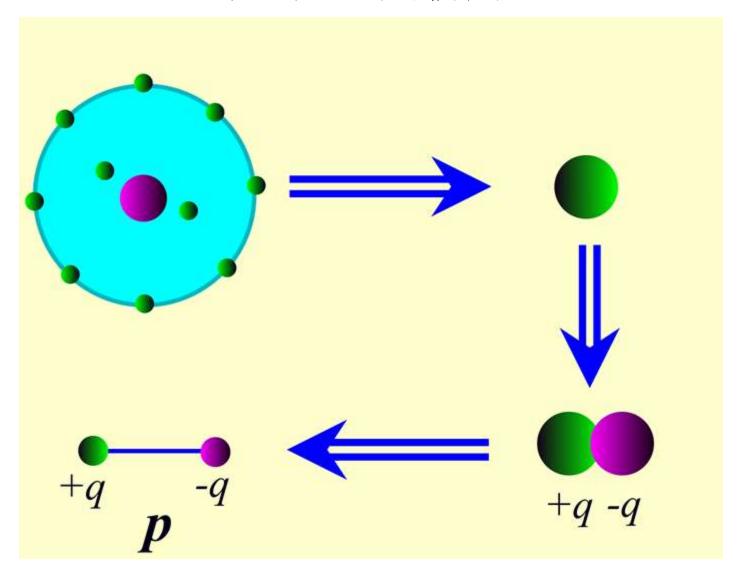
—— 体积减小,电子云的密度增大,电子的动能将增加

——原子实相互接近到一定的距离时,它们的电子云发生显著的重叠,将产生强烈的排斥作用

——金属性结合对原子的排列没有特殊的要求,容易造成原子排列的不规范性,使其具有很大的范性

- § 2.4 范德瓦耳斯结合
- ☑ VIII 族元素在低温时结合成的晶体 —— 非极性分子晶体
- ☑ 分子晶体的作用力
- ——惰性元素最外层8个电子,具有球对称的稳定封闭结构
- ——某一瞬时正负电中心不重合使原子呈现出瞬时偶极矩
- —— 使其它原子产生感应极矩
- ——非极性分子晶体依靠瞬时偶极矩的相互作用而结合
- ——作用力非常微弱
- —— 1873年范德瓦耳斯(Van der Waals) 提出在实际气体分子中,两个中性分子间存在着"分子力"

原子呈现出瞬时偶极矩



- ——惰性元素具有球对称,结合时排列最紧密以使势能最低
- ——Ne、Ar、Kr、Xe的晶体都是面心立方
- ——透明的绝缘体,熔点特低
- —— 分别为24K、84K、117K和161K
- ⋈ 两个惰性原子之间的相互作用势能
- —— 两个相距为r的原子,原子中电子是对称分布
- ——偶极矩作用
- 设原子1的瞬时电偶极矩 \bar{p}_1

在r处产生的电场 $E \sim \frac{P_1}{r^3}$

原子1的电场
$$E \sim \frac{p_1}{r^3}$$

原子2在电场的作用下感应偶极矩 $p_2 = \alpha E$ —— α 原子的极化率

两个电偶极子之间的相互作用能
$$\Delta E = \frac{p_1 p_2}{r^3} = \frac{\alpha p_1^2}{r^6}$$

- ——作用能与p₁的平方成正比,对时间的平均值不为零
- —— 力随距离增加下降很快,两个原子之间的相互作用很弱

两个原子的相互作用势能
$$u(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$$

—— B/r¹²: 重叠排斥势能,A和B为经验参数,都是正数

两原子相互作用势能

$$u(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$$

引入新的参量 ε and σ $4\varepsilon\sigma^6 = A$, $4\varepsilon\sigma^{12} = B$

相互作用势能
$$u(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{6} \right]$$

——勒纳一琼斯(Lennard-Jones)

势晶体总的势能 — N 个原子

$$U(r) = \frac{1}{2}N(4\varepsilon)[A_{12}(\frac{\sigma}{r})^{12} - A_{6}(\frac{\sigma}{r})^{6}]$$

——1/2因子:相互作用能为两个原子共有

 $----A_{12}和A_{6}$:与晶格结构有关的求和项

晶体总的势能
$$U(r) = \frac{1}{2}N(4\varepsilon)[A_{12}(\frac{\sigma}{r})^{12} - A_6(\frac{\sigma}{r})^6]$$

——非极性分子晶体的晶格常数、结合能和体变模量

晶格常数
$$\left. \frac{dU}{dr} \right|_{r=r_0} = 0$$

平衡状态体变模量
$$K = (V \frac{d^2U}{dV^2})_{V_0}$$

晶体的结合能 $W = -U(r_0)$

§ 2.5 元素和化合物晶体结合的规律性

电离能和电子亲和能

1.电离能

中性原子失去1个电子成为+1价离子时所需要的能量为 第一电离能,从+1价离子再移去一个电子所需的能量为第 二电离能。

$$z + A \rightarrow z^{+} + e$$

其中 A 为第一电离能

电离能越大,原子对价电子的束缚能力越强。

电离能 (单位:eV)

	元素	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
电离能		5.138	7.644	5.984	8.149	10.55	10.357	13.01	15.755
Ī	亡素	K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	kr
电	离能	4.339	6.111	6.00	7.88	9.87	9.750	11.84	13.996

2. 电子亲和能:

中性原子获得电子成为-1价离子时所放出的能量。

$$y + e \longrightarrow y^{-1} + B$$
 B为电子亲合能。

负电性

负电性=0.18(电离能+亲和能)

对比下表各个周期,可看出以下两个特性:

- (1)周期表由上到下,负电性逐渐弱;
- (2) 周期表越往下,一个周期内负电性的差别也越小。

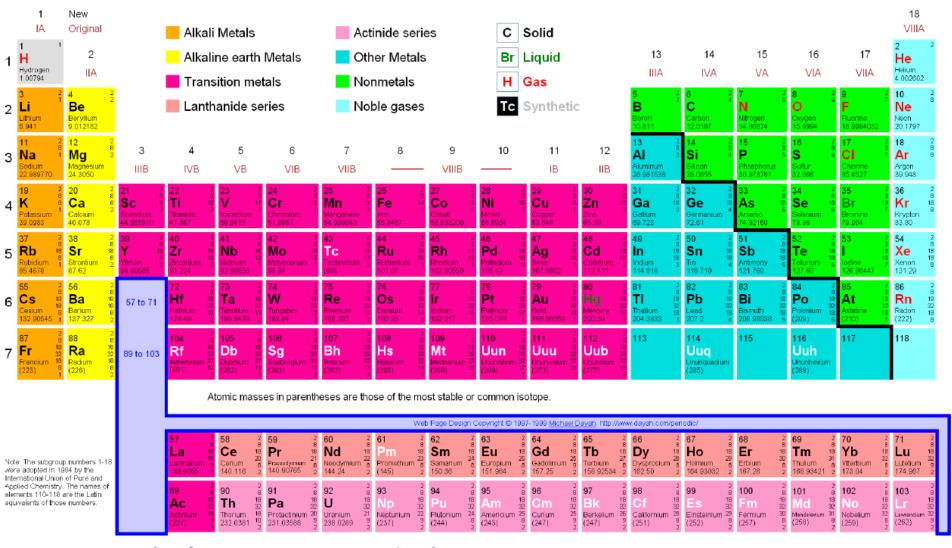
负 电 性

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA
Li	Be	В	C	N	O	F
1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
Na	Mg	Al	Si	P	\mathbf{S}	Cl
0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br
0.8	1.0	1.5	1.8	2.0	2.4	2.8

IA、IIA负电性低的元素对电子束缚较弱,价电子易于摆脱原子束缚成为共有化电子,因此在形成晶体时便采取典型的金属结合。

IVA、 VA具有较强的负电性,它们束缚电子的能力较强,适于形成共价结合。

周期表左端的元素负电性弱,易于失去电子;而右端的元素负电性强,易于获得电子,因此它们形成离子晶体。



一个有用的网上周期表 - http://www.webelements.com/

氢键和氢键晶体 H(1S1)(不作要求)

氢键是一种由于氢原子结构上的特殊性所仅能形成的特异键型!

1. 举例:

冰,铁电晶体 — 磷酸二氢钾(KH₂ PO₄),固体氟化氢[(HF)_n],蛋白质、脂肪、醣等含有氢键

2. 特点:

H原子只有一个1s电子,可以同时和<u>两个负电性较强</u>的而半径较小的原子结合 如:0、F、N

① 其中与一个结合较强,具有共价键性质 短键符号表示"一" 注: "共价键中电荷分布趋向负电性强的原子;

O、F、N负电性较强。

∴ H 原子核就相对露在外面 — 显示正电性

② 另一个靠静电作用同另一个负电性原子结合起来— 氢键(弱于Van der weals 键)

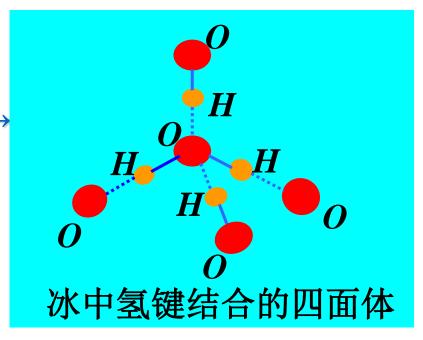
长键符号表示"…"

性质: 氢键具有饱和性和方向性

★ 饱和性:

 H_2O 晶体的键结构为 $O - H...O \rightarrow$ <u>第三个</u> O 原子向 H 靠近,受到已结合的两个 O 原子的负电排斥,不能与 H 结合

★ *方向性*: 冰,四面体结构



每个O原子按四面体结构形式 与其他4个H 邻接;

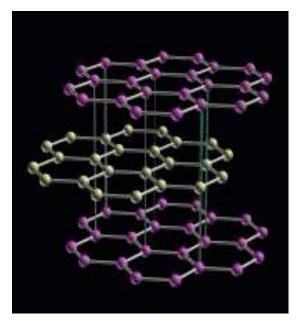
表明: 氢键能使分子按特定的方向联系起来!

混合键

例子:石墨一层状结构(二维)

1.由 C 原子组成,成键方式+金刚石

2.层内: 三个价电子 — sp^2 杂化,分别与相邻的三个C 原子 — 形成三个共价键(键长: 1.42Å)



粒子之间相互作用较强!



同一平面内,1200(六角平面网状结构)

平面上的所有 $2p_z$ 电子互相重叠 — 共价键

3. 层间:第三个 p_z 电子可沿层平面自由远动

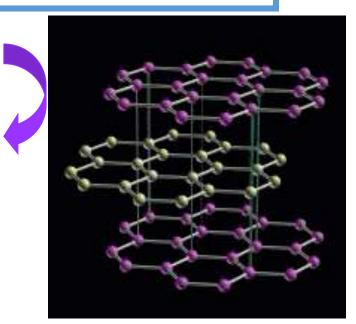
使其具有金属键的性质 — 使石墨晶体具有良好的导电性



网层间通过范德瓦尔斯力结合 — 分子键

层与层间的距离为3.40Å >> 一般的 C-C 链长

导致层与层之间易于滑移—表现石墨晶体特有的滑腻性质



性能:

层与层之间靠很弱的Vander weals键结合缺少电子表现层间导电率只有层内导电率的千分之一

层与层之间容易相对位移 → 碱金属,碱土金属,氧化物,硫化物等物质的原子或分子排成平行于石墨层的单层,按一定的次序插进石墨晶体的层与层的空间一石墨插层化合物

可改变导电率 → 达到层面内导电率超过铜→ 成为人造金属!